



가

EP-829559 A1

가

가  
EP-644588 A1

가 0.6mm/

CMOS

가 (1997), 2565 ~ 2750 )

, 1 $\mu$ m

가 P -  
CMOS

가  
( 가 P -  
가

가 ( 98-1 , 855 ~ 861 )

( )

GOI(gate oxide integrit

y, 가 LLS(localized light scatterers, )

GOI 가  
ITRS(International Roa

dmap For Semiconductors, ) 0.085 $\mu$ m

가 LLS 가  
0.18

$\mu$ m 가 38 (0.13 $\mu$ m )

가 LLS

38 LLS

, 38 LLS

CNOS

LLS 가

5\*10<sup>15</sup> atcm<sup>-3</sup> 가 0.1 ~ 50 cm , 7.5\*10<sup>17</sup> atcm<sup>-3</sup> 1\*10<sup>-13</sup> ~

가 , 0.2 ~ 1.0 $\mu$ m 0.085 $\mu$ m 가 30 LLS

4 5

가

~ 5\*10<sup>15</sup> atcm<sup>-3</sup> 0.1 ~ 50 cm , 7.5\*10<sup>17</sup> atcm<sup>-3</sup> 1\*10<sup>13</sup>

1120 가 ;

, 0.2 ~ 1.0 $\mu$ m 가

LLS 가 가 (>=3 $\mu$ m) 가 가

LLS 0.2 ~ 1 $\mu$ m 가

가

LLS 3 가 0.1 ~ 50 cm , 7.5\*10<sup>17</sup> atcm<sup>-3</sup> ,

0<sup>14</sup> atcm<sup>-3</sup> 6.5\*10<sup>17</sup> atcm<sup>-3</sup> 가 1\*10<sup>13</sup> ~ 5\*10<sup>15</sup> atcm<sup>-3</sup> , 1\*10<sup>14</sup> ~ 5\*1

1120 ~ 1200

(area counts),

가

DE-19823962 A

가

1050 ~ 900



3 :

		***)
( / ) **)	90	30
	0.33	1

\*\* ) 3

\*\*\* ) 3μm

가

LLS( )

가

(57)

1.

0.1 ~ 50 cm , 7.8\*10<sup>17</sup> atcm<sup>-3</sup> 1\*10<sup>13</sup> ~ 5\*10<sup>15</sup> atcm 가 ,  
 0.2 ~ 1.0μm 0.085μm 가 30 LLS

2.

1 , 6.5\*10<sup>17</sup> atcm<sup>-3</sup>

3.

1 , 1\*10<sup>14</sup> ~ 5\*10<sup>14</sup> atcm<sup>-3</sup>

4.

0.1 ~ 50 cm ; , 7.5\*10<sup>17</sup> atcm<sup>-3</sup> 1\*10<sup>13</sup> ~ 5\*10<sup>15</sup> atcm<sup>-3</sup> 가  
 , 0.2 ~ 1.0μm ; 가 1120 ~ 1170 가 ;

5.

0.1 ~ 50 cm 7.5\*10<sup>17</sup> ~ 5\*10<sup>15</sup> atcm<sup>-3</sup> 가 ; , 0.2 ~ 1.0μm 가 ;  
 1120 가 ;

6.

4 , 1050 ~ 900 90 , 가 1120 ~  
 1170

7.

4 , 1050 ~ 900 40 가 ,  
 1120 ~ 1200

8.

7 , 1130 ~ 1190

9.

4 , 가 가 , 가 ,  
 가 가

10.

4 , , 가 가 가 , , 가 ,  
가 , , 가 가 , , 가 ,  
.11.

4 , 1 ~ 10 .

12.  
4 , 50 가 .